製品カタログ

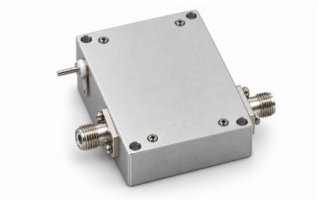
RFバイアスT・DCブロック

RFバイアスTはRF経路へ直流バイアスを注入・取り出し、DCブロックはRFを通しながら段間の直流電位を分離します。



製品: 2

改訂: 1 · 改訂日: 2026-11-08



LCBT-30-6000

30 MHz–6 GHz RFバイアスティー

30 MHz–6 GHzのRF経路にDCバイアスを注入します。原本表では挿入損失1 dBと動作電流0.3 Aが標準値です。

周波数範囲: 値: 30–6000; 単位: MHz; 注記: 最小: 30 MHz. 最大: 6000 MHz.

挿入損失: 値: 1; 単位: dB; 注記: 代表: 1 dB.

リターンロス: 値: −15; 単位: dB; 注記: 代表: -15 dB.

動作電圧: 値: 5 / 12; ≤30; 単位: V; 注記: 代表: 5/12 V. 最大: 30 V.

製品詳細　製品データシート



LCBT-6000-9000

6–9 GHz RFバイアスティー

LCBT-6000-9000は、マイクロ波測定系で6–9 GHzのRF信号にDCバイアスを重畳するバイアスティーです。挿入損失は標準1 dB、動作電流は標準0.3 Aです。

周波数範囲: 値: 6000–9000; 単位: MHz; 注記: 最小：6000 MHz。最大：9000 MHz。

挿入損失: 値: 1; 単位: dB; 注記: 代表: 1 dB.

入力・出力の反射特性 (S11): 値: −15; 単位: dB; 注記: 代表: -15 dB.

動作電圧: 値: 5 / 12; ≤30; 単位: V; 注記: 代表: 5/12 V. 最大: 30 V.

製品詳細　製品データシート

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。